

УДК 621.375.592

ХИМИЧЕСКИЙ СДВИГ МЕЛКИХ ПРИМЕСНЫХ УРОВНЕЙ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Н. Н. Аблязов, М. Ю. Кучинев

Вычислена энергия основного состояния мелкого донора в полупроводнике с параболической зоной проводимости в магнитном поле для разных значений химического сдвига в адиабатическом приближении. Энергия уровня немонотонно зависит от поля для отрицательных значений химсдвига.

1. Мелкие заряженные примеси в полупроводниках, как правило, описываются в приближении эффективной массы [1]. Потенциал примеси считается кулоновским

$$V(r) = -Ze^2/\pi r, \quad (1)$$

что в случае невырожденной параболической зоны проводимости приводит к боровской серии для уровней энергии донора

$$\left. \begin{aligned} E_n &= E_B/(1+n)^2, \\ E_B &= \frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2\pi^2}, \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

где Z — его заряд, π — диэлектрическая проницаемость, m — эффективная масса зоны, E_n — энергия n -го уровня. Метод эффективной массы справедлив, если боровский радиус электрона $a_B = \hbar^2\pi^2/mZe^2$ гораздо больше постоянной решетки.

Энергетическая серия (2) определяется только параметрами полупроводника и не зависит от химической природы доноров. Однако на расстояниях порядка постоянной решетки потенциал примесного центра отличается от кулоновского. Поэтому энергия основного состояния от боровской отличается. Это отличие называют химическим сдвигом Δ_0 . В ряде полупроводников для разных примесей влияние короткодействующей части потенциала относительно мало: $|\Delta_0| \ll E_B$. Такие примеси называются мелкими. Влиянию сильного магнитного поля на спектр таких примесей и посвящена настоящая работа.

Величину химического сдвига можно определить с помощью метода магнитной спектроскопии [2]: измеряется поглощение электромагнитной волны фиксированной энергии при изменении приложенного к образцу постоянного магнитного поля H . Резонанс — совпадение энергии связи $\epsilon(H) = E_B(H) + \Delta(H)$ с квантом света — происходит для доноров разной химической природы при разных магнитных полях. Зависимость боровской энергии от магнитного поля $E_B(H)$ совпадает с соответствующей зависимостью для атома водорода (надо только заменить массу свободного электрона на эффективную, а величину e^2 на Ze^2/π) и неоднократно вычислялась [3]. Что касается зависимости химсдвига от поля, то для него, как правило, используется теория возмущений [4]

$$\frac{\Delta(H)}{\Delta_0} = \left| \frac{\Psi_{II}(0)}{\Psi_{II=0}(0)} \right|^2, \quad (3)$$

где $\Psi_H(r)$ — волновая функция боровского электрона в магнитном поле. Определяя экспериментально точку резонанса, можно с помощью (3) вычислить величину химсдвига Δ_0 .

В полупроводниках боровский радиус и магнитная длина $\lambda = (c\hbar/eH)^{1/2}$ значительно превосходят межатомное расстояние. При этом воздействие короткодействующего потенциала на электрон характеризуется только одним параметром — длиной рассеяния на коре l . По порядку величины она сравнима с межатомным расстоянием, и поэтому $|l| \ll a_B, \lambda$.

Известно [5], что химсдвиг выражается через длину рассеяния следующим образом

$$\frac{\Delta_0}{2E_B} = 2 \frac{l}{a_B}. \quad (4)$$

Ниже нам будет удобно использовать эффективный потенциал Ферми [5, 6], т. е. такой короткодействующий потенциал $U(r)$, для которого выполняется условие

$$\frac{1}{2\pi} \int d^3r U(r) = \frac{\hbar^2}{2m} l. \quad (5)$$

В данной работе предполагаются выполненные неравенства

$$|l| \ll \lambda \ll a_B. \quad (6)$$

Условие $\lambda \ll a_B$ предполагает, что магнитное поле сильное и позволяет использовать так называемое адиабатическое приближение [7], а неравенство $|l| \ll \lambda$ — пренебречь воздействием магнитного поля на потенциал кора.

Оказывается, что при выполнении (6) имеется простое трансцендентное уравнение, определяющее энергию связи электрона на доноре в магнитном поле. Оно получено в следующем разделе.

Анализ этого уравнения показывает, что воздействие кора на спектр характеризуется одним безразмерным параметром ν

$$\nu \equiv \frac{a_B l}{\lambda^2}. \quad (7)$$

В случае малых ν , $|\nu| < 1$ справедлива теория возмущений, применимо уравнение (3). С ростом $|\nu|$ в области $|\nu| \geq 1$ теория возмущений становится непригодной.

Интересной оказывается зависимость энергии уровня от поля в случае отталкивательного кора, $\nu < 0$. Известно [1, 6, 7], что без учета кора в сильном поле уровень углубляется. Наличие кора меняет ситуацию качественно. С ростом поля энергия увеличивается только в области $|\nu| < 1$, достигая при $|\nu| \approx 1$ максимального значения. При $|\nu| \gg 1$ энергия уровня убывает по закону

$$\epsilon(H) \simeq E_B \left(1 + \frac{4}{|\nu|} \right). \quad (8)$$

Интересно, что энергия асимптотически стремится к E_B . Этот результат отличается от предсказания теории возмущений. Согласно (3), $\epsilon(H) \rightarrow 0$ при $H \rightarrow \infty$.

Результат (8) имеет простое физическое объяснение. С ростом поля волновая функция сжимается. При этом растет вклад в энергию как кулоновского потенциала, так и потенциала кора. Вначале вклад кулоновского потенциала доминирует, поэтому уровень углубляется. При достаточно сильном поле более важным оказывается короткодействующий потенциал, который при $l < 0$ стремится вытолкнуть уровень.

Асимптотика уровня при $\nu < 0$, $|\nu| \gg 1$ определяется следующим обстоятельством. В сильном поле задача фактически сводится к одномерному движению электрона в кулоновском поле. Короткодействующий отталкивательный потенциал приводит к тому, что в сильном поле на вол-

новую функцию накладывается условие $\Psi(0) \sim \text{const}/|v| \rightarrow 0$. Следовательно, задача становится полностью аналогичной задаче о трехмерном атоме водорода (без магнитного поля).

При приложении к полупроводнику с металлической проводимостью магнитного поля теория предсказывает переход к активационной проводимости. При слабой компенсации это связано с вымораживанием электронов проводимости на доноры из-за увеличения боровской энергии в магнитном поле $E_B(H) > E_B(H=0)$. Однако, как уже было сказано, для полупроводника с примесями с мощным отталкивательным кором в сильном поле $\epsilon(H) \sim E_B$. Это может привести к отсутствию перехода металл—диэлектрик в магнитном поле.¹

1. Адиабатическое приближение

Волновую функцию основного состояния $\Psi(\rho, z)$ точного уравнения Шредингера следует разложить [6] по полной системе радиальных функций $R_{n0}(\rho)$ уровней Ландау

$$\Psi(\rho, z) = \sum_n R_{n0}(\rho) \chi_n(z). \quad (9)$$

Здесь и ниже ось z выбрана вдоль поля H .

При $a_B > \lambda$ расстояние между уровнями Ландау гораздо больше характерной боровской энергии, так что в разложении (9) можно оставить только член, соответствующий нулевому уровню Ландау. Эта процедура составляет суть адиабатического приближения [7]. При этом одномерная функция $\chi_0(z)$ удовлетворяет одномерному уравнению Шредингера [6, 7]

$$\left. \begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \chi_0}{dz^2} + \bar{W}(z) \chi_0 &= -\epsilon(H) \chi_0, \\ W \equiv V(r) + U(r), \quad \bar{W}(z) &= \int_0^\infty d\rho \rho W(\sqrt{\rho^2 + z^2}) R_{00}^2(\rho), \\ \epsilon(H) &= \frac{\hbar^2}{m\lambda^2} - E(H). \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

Здесь U — эффективный потенциал кора, удовлетворяющий условию (5). Поправки к адиабатическому приближению мы оценим в следующем разделе [8].

Энергию уровня ϵ можно определить из условия непрерывности волновой функции и ее производной. Для этого, вычислим логарифмическую производную волновой функции в области $\lambda \ll z \ll a_B$. При $z \gg \lambda$ уравнение (10) совпадает с уравнением Шредингера кулоновской задачи, следовательно, волновая функция здесь кулоновская. Поскольку $z \ll a_B$, то кулоновскую функцию можно раскладывать по степеням малых расстояний. В результате находим [6]

$$\eta \equiv a_B \frac{\chi'_0}{\chi_0} \Big|_z \simeq - \left\{ k + 2 \left[\ln \frac{2kz}{a_B} + \psi(1 - k^{-1}) + 2C \right] \right\}, \quad (11)$$

где $k^2 \equiv E(H)/E_B$ — энергия в боровских единицах, $C \approx 0.577 \dots$ — постоянная Эйлера, $\psi(x)$ — логарифмическая производная гамма-функции.

Вычислим теперь ту же величину η , интегрируя (10) от нуля до z . Используя граничное условие $\chi'_0(z \rightarrow 0)$, находим

$$\eta \simeq \frac{2ma_B}{\hbar^2} \int_0^z \bar{W}(z) dz, \quad (12)$$

а поправочные члены при $|L| \ll \lambda \ll z \ll a_B$ малы, как показано в следующем разделе. Отметим, что даже одномерное адиабатическое уравнение (10) при переходе к формуле (12) решено приближенно.

¹ Авторы благодарны А. Л. Эфросу, указавшему нам на эту возможность.

Интеграл с кулоновским потенциалом в выражении (13) легко вычисляется

$$\int_0^z \bar{V}(z') dz' \simeq -Z \frac{e^2}{z} \left[\ln \frac{\sqrt{2} z}{\lambda} + \frac{C}{2} + 0\left(\frac{\lambda^2}{z^2}\right) \right], \quad (13)$$

а вместо короткодействующего потенциала можно ввести длину рассеяния на эффективном потенциале кора (5), если только $|L| \ll \lambda$. В этом случае можно пренебречь воздействием магнитного поля на потенциал кора.

Из выражений (5), (11), (13) находим трансцендентное уравнение для определения энергии связи

$$\left. \begin{aligned} \Phi(k) &= 2 \ln \frac{a_B}{\sqrt{2} \lambda} + \frac{La_B}{\lambda^2}, \\ \Phi(k) &\equiv k + 2 \ln k + \Psi(1 - k^{-1}) + 3C. \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

Уравнение (14) — основной результат работы. Его правая часть зависит от двух существенных параметров задачи: $\nu \equiv La_B/\lambda^2$, $\ln a_B/\lambda$. При $\nu=0$ это уравнение сводится к адиабатическому уравнению Хасегавы—Ховарда [7] для определения энергии основного состояния атома водорода в магнитном поле. При этом асимптотическая зависимость энергии от магнитного поля описывается формулой

$$E_B(H) = E_B \ln^2 \frac{a_B^2}{2\lambda^2}, \quad (15)$$

которая справедлива при $\ln a_B/\lambda \gg 1$, когда величина $\Phi(k) \approx k \gg 1$. Поправки к формуле (15) определяются параметром $\lambda/a_B \ln a_B/\lambda \ll 1$ [8].

Интересно, что величина ν , входящая в уравнение (14), может быть немалой по сравнению с логарифмом в области применимости (6). В этом случае химсдвиг $\Delta(H)$ уже нельзя вычислять по теории возмущений (3). Ее область применимости оказывается ограниченной условием $|\nu| < < \ln(a_B/\lambda)$, т. е. пока $\Delta(H) < E_B(H)$. При этом

$$\varepsilon \simeq E_B(H) \left[1 + \frac{4\nu}{\ln \frac{a_B}{\sqrt{2} \lambda}} \right]. \quad (16)$$

Последнее выражение справедливо при $\ln a_B/\lambda \gg 1$ и совпадает с формулой теории возмущений (3), так как в этом случае $\psi_H(0) \approx (2\pi\lambda^2)^{-1/2} \sqrt{k/a_B}$, причем $k \simeq 2 \ln a_B / \sqrt{2} \lambda$.

На рисунке построены зависимости энергии основного состояния электрона на доноре в магнитном поле, полученная из (14) для двух исходных значений химсдвига $\Delta_0/E_B = \pm 0.1$. Там же для сравнения приведены аналогичные зависимости для атома водорода ($\Delta_0=0$), полученная в адиабатическом приближении [7], и точного решения [3], полученного на ЭВМ. Мы полагаем, что точность нашего расчета такая же, как и в случае $\Delta_0=0$.

Из рис. 1 видно, что теория возмущений нарушается при $|\nu| \sim 1$. Для отрицательных значений химсдвига $\Delta_0 < 0$ энергия уровня немонотонно зависит от магнитного поля. В достаточно сильном поле, когда $|\nu| \gg 1$, в левой части уравнения (14) главным становится член, пропорциональный ψ -функции, что приводит к падающей от магнитного поля зависимости (8).

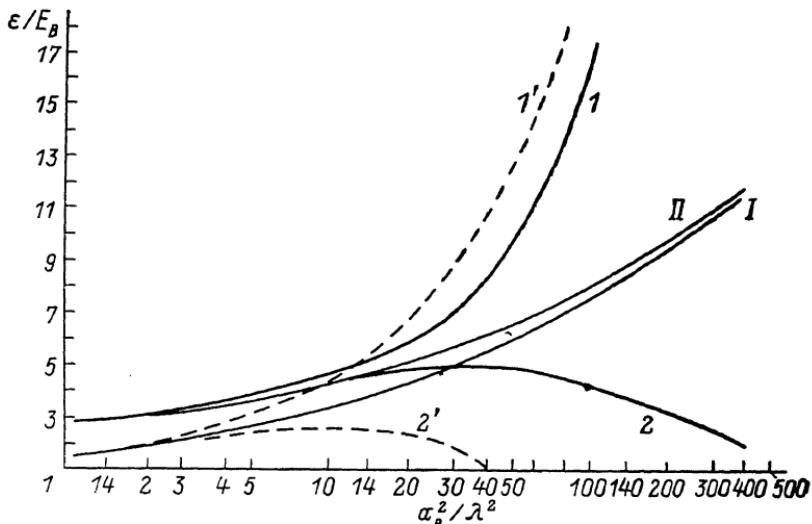
Напомним, что построенная теория справедлива при $|L| \ll \lambda \ll a_B$. Поправочные члены оценены в следующем разделе. В очень сильном поле, когда магнитная длина сравнивается с длиной рассеяния $\lambda/|L| \sim 1$, одномерное приближение становится несправедливым, и необходимо решить точное уравнение.

2. Поправки к адиабатическому приближению

Оценим поправки к энергии от учета верхних зон Ландау. Если подставить в полное трехмерное уравнение Шредингера [6] точное разложение (9), то для продольных функций $\chi_n(z)$ получится система уравнений

$$\left. \begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \chi_n}{dz^2} + \sum_q \bar{W}_{nq}(z) \chi_q &= -\left[\frac{\hbar^2}{m_e^2} \left(n + \frac{1}{2} \right) - E(H) \right] \chi_n, \\ \bar{W}_{nq}(z) &= \int_0^\infty d\rho \rho R_{n0}(\rho) W(\sqrt{\rho^2 + z^2}) \chi_{q0}(\rho). \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

Отброшенные в адиабатическом приближении члены от верхних зон в уравнении для $\chi_0(z)$ можно учесть по теории возмущений. Характерные значения z^* для потенциала (1), как будет видно, $z^* \sim \lambda$, а для коротко-



Зависимость уровня энергии донора от магнитного поля для двух значений химсдвига: $\Delta_0/E_B = \pm 0.1$ — кривые 1, 2 соответственно — решения уравнения (14).

Кривые 1', 2' — результаты теории возмущений (3) для тех же значений химсдвига. Кривые I, II — соответственно точный [3] и адиабатический [7] расчеты энергии основного состояния электрона в атоме водорода ($\Delta_0=0$) от магнитного поля.

действующего потенциала — $z^* \sim |l|$ [7]. При этом в первом порядке по членам, пропорциональным $\chi_q(z)$, следует для оценки поправки в уравнение (10) вставить потенциал

$$\frac{1}{\hbar \omega_c} \sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q} \bar{W}_{q0}^2(z), \quad \hbar \omega_c \equiv \frac{\hbar^2}{m_e^2}, \quad (18)$$

что приводит к поправке для энергии

$$\varepsilon^{(1)} \sim \frac{1}{\hbar \omega_c} \sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q} \int_{-\infty}^{\infty} dz \chi_0^2 \left[\int_0^{\infty} d\rho \rho (V + U) R_{q0} R_{q0} \right]^2. \quad (19)$$

При этом для кулоновского потенциала

$$\varepsilon_{\text{кул}}^{(1)} \sim \frac{1}{\hbar \omega_c} \chi_0^2(0) l e^4 / \kappa^2 \sim \frac{l}{a_B} \ln \frac{a_B}{\lambda} E_B, \quad (20)$$

как уже показано было ранее [8]. Для короткодействующего потенциала в первом порядке по $|l|/\lambda$ из (19) получим

$$\varepsilon_{\text{кор}}^{(1)} \sim e^2 \chi_0^2(0) l / \lambda \sim \frac{l}{\lambda} \ln \frac{a_B}{\lambda} E_B. \quad (21)$$

Таким образом, поправки от учета верхних зон Ландау определяются формулами (19)–(20), в оценке мы положили $\chi_0(0) \sim (k/a_B)^{1/2}$.

Кроме того, напомним, что одномерное уравнение (10) было решено приближенно. При переходе к формуле (12) были отброшены член, пропорциональный $[(\chi'/\chi)|_z]^2$, и член, пропорциональный энергии, по сравнению с $m\tilde{W}/\hbar^2$. Это справедливо при

$$\ln^2 \frac{z}{\lambda} + O\left(\frac{\lambda^2}{z^2}\right) < \frac{a_B}{\lambda}, \quad \frac{a_B l}{\lambda^2} \ln \frac{z}{\lambda} < \left(\frac{a_B}{\lambda}\right)^2,$$

как следует из формул (12), (10). Видно, что решено адиабатическое уравнение при тех же приближениях, в которых оно справедливо.

Авторы признательны А. Л. Эфросу за постановку задачи, многочисленные и полезные обсуждения. Благодарим Ал. Л. Эфроса за обсуждение результатов работы и консультации по литературным источникам.

Л и т е р а т у р а

- [1] Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979. 416 с.
- [2] Голубев В. Г., Иванов-Омский В. И. В кн.: Материалы XII зимней школы по физике полупроводников. Л., 1986, с. 146–179.
- [3] Makado P. C., McGill N. C. J. Phys. C, 1986, vol. 19, N 6, p. 873–885.
- [4] Cabib D., Fabri E., Fiori G. Sol. St. Commun., 1971, vol. 9, N 17, p. 1517–1520.
- [5] Зельдович Я. Б. ФТТ, 1959, т. 1, № 11, с. 1638–1641.
- [6] Ландау Л. Д., Либшиц Е. М. Квантовая механика. М.: Наука, 1974.
- [7] Hasegawa H., Howard R. E. J. Phys. Chem. Sol. 1961, vol. 21, N 1, p. 179–193.
- [8] Avron J. E., Herbst I. W., Simon B. Phys. Rev. A, 1979, vol. 20, N 6, p. 2287–2296.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
1 февраля 1988 г.